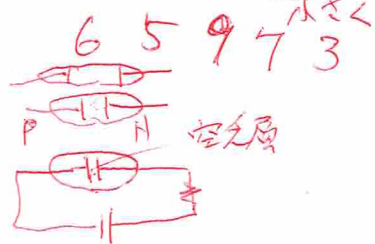
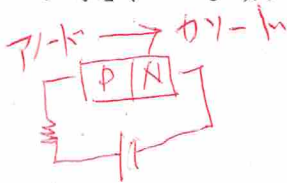


B-2 次の記述は、ダイオードについて述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) シリコン(Si)等の一つの結晶内にP形とN形の半導体の層を作ったとき、この層を接した状態をPN接合といい、この構造をもつダイオードをPN接合ダイオードという。シリコン(Si)を用いた接合ダイオードは□ア方向電流が非常に少なく、整流用の素子として広く用いられている。
- (2) PN接合ダイオードに加える逆方向電圧を大きくしていくと、ある電圧で電流が急激に増加する。これを□イといい、この特性を利用するダイオードを□ウダイオードという。^{1/2+}
- (3) PN接合ダイオードに加える逆方向電圧を増加させるほど空乏層の幅が広がるので、接合部の静電容量は□エなる。この特性を利用するダイオードを□オダイオードという。

- 1 順 2 大きく 3 バラクタ 4 トンネル 5 降伏現象
- 6 逆 7 小さく 8 ガン 9 ツェナー 10 ホール効果



(HZ512-7)

1. 次の文の空欄に適切な語句を下のリストから選べ。ただし、1個は重複して選ばれる。また、1個は重複して選ばれる。

V-22 次の文の空欄に適切な語句を下のリストから選べ。ただし、1個は重複して選ばれる。また、1個は重複して選ばれる。

- 1. 整流素子 2. 整流素子 3. 整流素子
- 3. 整流素子 4. 整流素子 5. 整流素子
- 5. 整流素子 6. 整流素子 7. 整流素子
- 7. 整流素子 8. 整流素子 9. 整流素子



- P □B □E
- I □U □O

V-24 次の文の空欄に適切な語句を下のリストから選べ。ただし、1個は重複して選ばれる。また、1個は重複して選ばれる。